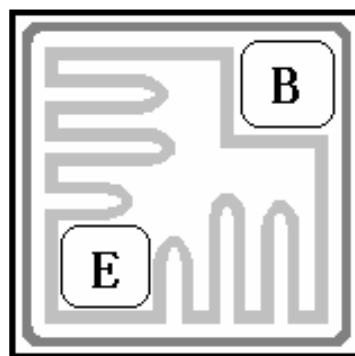




芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：A047BJ-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：470 × 470μm²
 焊位尺寸：B 极 103×103μm²，E 极 98×98μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：SS9012，H9012，8550S

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....625mW
 V_{CB0}——集电极—基极电压.....-40V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....-20V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....-5V
 I_C——集电极电流.....-700mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{CB} =-25V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{EB} =-3V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	80		390		V _{CE} =-1V, I _C =-50mA
		40				V _{CE} =-1V, I _C =-500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-0.6	V	I _C =-500mA, I _B =-50mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	I _C =-500mA, I _B =-50mA
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压	-0.6		-0.73	V	V _{CE} =-1V, I _C =-10mA
BV _{CB0}	集电极—基极击穿电压	-40			V	I _C =-100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-20			V	I _C =-1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-100μA, I _C =0